

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЗАО  
"НТЦ Схемотехники  
и Интегральных Технологий"

\_\_\_\_\_ В.И. Громов

\_\_\_\_\_ 2000 г.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ  
типа КР1182КП1

«ИС диодного симистора с фиксированным напряжением открывания».

Технические условия главного конструктора  
ЮФЗ.438.023

Срок введения - с момента утверждения  
Срок действия - до серийного освоения

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам инв. №	Подп. и дата
Инд. № дубл.	Подп. и дата

«СОГЛАСОВАНО»

Инженер СККП

\_\_\_\_\_ И. Илюшкин

\_\_\_\_\_ 2000 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Главный конструктор ОКР

\_\_\_\_\_ С. Коновалов

\_\_\_\_\_ 2000 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие технические условия распространяются на опытные образцы микросхем типа КР1182КП1.

1.2 Условное обозначение опытного образца микросхемы при заказе "Микросхема КР1182КП1(А,Б,В)" по ЮФЗ.438. 023ТУГК.

## 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Микросхема собирается в трехвыводном пластмассовом корпусе КТ-26 (ТО-92) ГОСТ 18472-88.

2.2 Схема электрическая и назначение выводов приведены на рис. 1.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

3.1 Электрические параметры при приемке (поставке), а также в течение времени наработки и срока сохраняемости при эксплуатации микросхем в соответствии с настоящим ТУ должны соответствовать таблице 1.

3.2 Значения электрических параметров в таблице 1, если не оговорено особо, приводятся при температуре 25С°.

3.3 Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации приведены в таблице 2.

## 4.ПРАВИЛА ПРИЕМКИ - ПОСТАВКИ.

4.1 Микросхемы КР1182КП1 поставляются по результатам проверки параметров в объеме таблицы 1 настоящих ТУ.

4.2 На микросхемы должно быть нанесено обозначение типа микросхемы 1182КП1(А,Б,В). Другие требования к внешнему виду не предъявляются.

4.3 Микросхемы поставляются в групповой упаковке. Коробка должна быть заклеена бандеролью с указанием типа микросхемы с надписью «Опытные образцы», количества, номера ТУ ГК, месяца и года изготовления, штампа ОТК.

## 5. ГАРАНТИИ.

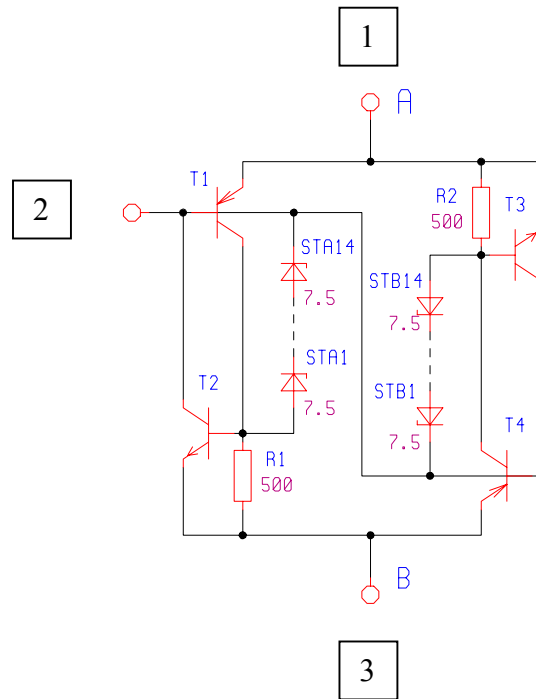
5.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие микросхем требованиям настоящих ТУ.

При оценке потребителем соответствия электрических параметров микросхем требованиям настоящих ТУ следует руководствоваться нормами, приведенными в таблице 1.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам инв №	Индв № дубл
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЮФЗ 438.023			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат				
Разраб.		Коноплева			Технические условия главного конструктора на интегральные микросхемы типа КР1182КП1	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Коновалов					2	6
Н.контр								
Утв.		Ястребов						

5.2 Микросхемы, забракованные на входном контроле у потребителя или отказавшие при технологических испытаниях аппаратуры, возвращаются предприятию - изготовителю для исследования причин отказов и замены на годные не позднее трех месяцев с момента поставки. Рекламации не выставляются.



- 1- Вход 1(А),
- 2- Свободный вывод
- 3- Вход 2 (В)

Рис. 1 Схема электрическая КР1182КП1 и назначение выводов.

Инь.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инь.№ дубл.
Подп. и дата	
Изм	Лист
№докум	Подп
	Дата

ЮФ3.438.023

Лист

3

Таблица 1

Наименование параметра, ед. измерения	Букв. обозн.	Норма не менее	Норма не более	Режим измерен.
1. Ток удержания, мА КР1182КП1 КР1182КП1А КР1182КП1Б КР1182КП1В	$I_H$		10 10 1 10	$V_{p1}=2В$ $V_{p1}=2В$ $V_{p1}=2 В$ $V_{p1}=2 В$
2. Ток в закрытом состоянии, мкА КР1182КП1 КР1182КП1А КР1182КП1Б КР1182КП1В	$I_b$		100 100 100 100	$V_{p2}=90 В$ $V_{p2}=7.0 В$ $V_{p2}=18 В$ $V_{p2}=75 В$
3. Падение напряжения во включенном состоянии, В	$V_F$		2.2	$I_F=600 мА$
4. Максимальное импульсное напряжение для КР1182КП1, В	$V_O$	75	-	$C_C=0.1\mu F$ , $R_L=20 \Omega$
5. Напряжение отпирания симистора, В КР1182КП1 КР1182КП1А КР1182КП1Б КР1182КП1В	$V_s$	95 7.5 19 80	115 9.5 26 93	

Примечание.

Типовые значения параметров:

Время включения,  $t_{on}$  0.1 мкс

Время выключения,  $t_{off}$  70 мкс

Температурный коэффициент напряжения отпирания, %/°C ( $T_c$  -10... +70°C) 0.04

Инв.№ подл. Подп. и дата

Инв.№ дубл. Подп. и дата

Инв.№ инв.№ Взам. инв.№ Подп. и дата

Инв.№ подл. Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

ЮФ3.438.023

Лист

4

Таблица 2

Наименование параметра, единица измерения	Букв. обознач.	Норма	
		Предельно- допустимый режим	
		Не менее	Не более
1 Рассеиваемая мощность, Вт	P		0.5
2 Предельно допустимый постоянный ток, А	I <sub>F</sub>		1.0
3 Предельно допустимый импульсный ток (Скважность 1%, длительность импульса 10 мкс, T=70°C)	I <sub>FM(rep)</sub>		3.0
4 Предельно допустимый импульсный ток (импульс 10 мкс T=25°C), А	I <sub>FM(nonrep)</sub>		6.0
5 Диапазон рабочих температур, °C	T <sub>A</sub>	-10 ... +70	
6 Диапазон температур хранения, °C	T <sub>stg</sub>	-65... +150	

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

ЮФ3.438.023

Лист

5

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум.	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ губл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

ЮФ3.438.023

Лист
6